

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年8月21日(21.08.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/126150 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/28 (2006.01) *H01L 21/56* (2006.01)
B32B 3/30 (2006.01) *H01L 23/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/053321
- (22) 国際出願日: 2014年2月13日(13.02.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-027942 2013年2月15日(15.02.2013) JP
特願 2014-022331 2014年2月7日(07.02.2014) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 鳥成 剛(TORINARI, Tsuyoshi); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 清水 祐作(SHIMIZU, Yusaku); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 豊田 英志(Toyoda, Eiji); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒

5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).

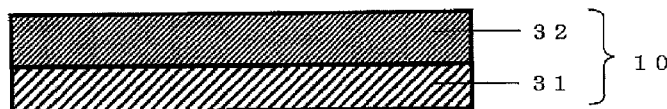
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: SEALING SHEET FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT, SEMICONDUCTOR DEVICE, AND SEMICONDUCTOR-DEVICE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 半導体素子用封止シート、半導体装置及び半導体装置の製造方法



(57) Abstract: Provided are a sealing sheet for a semiconductor element, and a production method, with which a semiconductor device enabling information referred to by markings to be rendered satisfactorily visible can be produced. The present invention relates to a sealing sheet for a semiconductor element, said sealing sheet being provided with: a release film provided with a surface state in which the surface smoothness (Ra) is 0.1-0.5 μm and the unevenness average interval (RSm) is 90-125 μm ; and a sealing-material layer disposed upon the release film.

(57) 要約: マーキングで付された情報を良好に視認可能な半導体装置を製造できる半導体素子用封止シート及び製造方法を提供する。表面平滑性 (Ra) 0.1~0.5 μm 及び凹凸平均間隔 (RSm) 90~125 μm の表面状態を備える離型フィルム、並びに前記離型フィルム上に配置された封止材層を備える半導体素子用封止シートに関する。



WO 2014/126150 A1